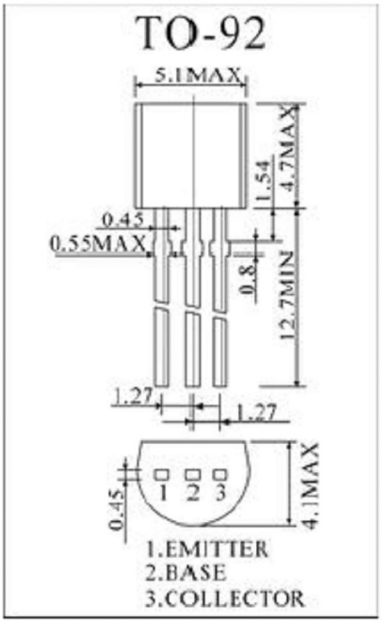
DAYA
臺源國際股份有限公司

TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors

9012

—PNP silicon—



■■绝对最大额定值（Ta＝25℃）

项　　目	符　号	额定值	单　位
集电极—基极电压	V_{CBO}	-40	V
集电极—发射极电压	V_{CEO}	-20	V
发射极—基极电压	V_{EBO}	-5	V
集电极电流	I_C	-500	mA
集电极耗散功率	P_C	600	mW
结　　温	T_J	150	℃
存储温度	Tstg	- 55~150	℃

■■电参数（Ta=25℃）

项　　目	符　号	最小值	典型值	最大值	单位	测　试　条　件
直流电流增益	h_{FE}	64		300		V_{CE}= -1 V，Ic= -50 mA
集电极-基极截止电流	I_{CBO}			0.1	μA	V_{CB}=-25 V，I_E=0
发射极-基极截止电流	I_{EBO}			0.1	μA	V_{EB}= -3 V，Ic=0
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	-40			V	Ic=-0.1 mA，I_E=0
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	-20			V	Ic=-1 mA，I_B=0
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	-5			V	I_E=- 0.1mA，Ic=0
基极-发射极电压	$V_{BE(ON)}$	-0.6	-0.67	-0.7	V	V_{CE}=-1 V，Ic= -10mA
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$		-0.18	-0.6	V	Ic=-500 mA，I_B=-50 mA
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$		-0.95	-1.2	V	Ic=-500 mA，I_B=-50 mA

■■h_{FE} 分档及其标志

分档	D	E	F	G	H	I
h_{FE}	64～91	78～112	96～135	112～166	144～202	200～300